

16th Collaboration Meeting between University of the Ryukyus and Hoseo University

琉球大学・湖西大学 研究交流ミーティング

於：日本 沖縄 (琉球大学会議室)

報告者 鈴木 仁 (理工学研究科 2年)

工学部 野口 (&岡田) 研究室

2018年1月12日に琉球大学(工学部、理工学研究科)と交流協定を結んでいる韓国の湖西(ホソウ)大学のProf. Baeの研究室のメンバーと共同研究技術ミーティングを行いました。琉球大学からは、野口 隆教授と岡田 竜弥助教と学生7名を含めた9名が参加しました。両研究室の交流は、毎年、日本と韓国で1回ずつ行い、これまで活発に行われており、今回で早くも16回目となります。交換留学も盛んに行われており、本年度前期には、湖西大学から2名の学生が琉球大学工学部(本研究室)に滞在しており、4月からは4名(うち3名が電子工学関連)が本学に滞在の予定です。このような両研究室の強い結びつきにより、今回のミーティングが開催されました。



集合写真



ミーティングの様子

ミーティングは、湖西大学と本研究室の学生が、半導体や次世代薄膜デバイスに関する研究成果を紹介し、活発に議論しました。

今後の研究の発展に繋がるような意見やアドバイスを頂き、より先端技術研究への意識を高めることができ、国際的な研究推進の意欲に刺激を受けることが出来ました。

今後、互いにより良い友好関係を築きつつ、国際感覚を養い、最先端の技術を目指して共同研究を進めて、将来は、世界をリードしていきたいと思います。このような機会をくださった学長、理事をはじめ本部国際課の方々、また理工学研究科(工学部)の学部長、教職員の方々、湖西大学側の学部長、研究科長、学部長や Prof. B. S. BAE に感謝します。

第 16 回 琉球大学・湖西大学共同技術ミーティング スケジュール

January 12 (Fri.) 10:00-17:00 at University of the Ryukyus

(於：地域創生総合研究棟 1 F)

Greeting
& Meeting

Time	Topic	Speak	Grade
10:00~10:10	Introduction remark by Prof. Bae	B. S. Bae	Prof.
10:10~10:20	Introduction remarks by Prof. Noguchi and Okada	T. Noguchi and T. Okada	Prof.
10:20~10:30	Introduction to Hoseo University (Japanese)	H. C. Yang	U
10:40~11:00	Magnetic sensor on flexible panel	C. J. Koswaththage	D3
11:00~11:20	Compact Decoder-Type Gate Driver Circuit with a-IGZO TFT for Stretchable Display	I. H. Kang	D1
11:35~11:50	Coffee Break		
11:50~12:05	Si TFT on PI	F. Gakiya	M2
12:05~12:20	The Oxide TFT with Solution Based Gate Insulator	M. T. Hong	M2
12:20~12:30	Insulator Characteristics of Solution Al_2O_3	S. H. Hong	U
12:30~12:45	Junction formation for solar cell	J. Suzuki	M2
12:45~13:30	Lunch		
13:30~13:40	Comparison of galaxy Note 8 and V30	J. M. Joo	U
13:40~13:55	Effect of Gate Insulators by Diluted Spin On Glass on IGZO Thin Film Transistor	S. H. Hwang	M1
13:55~14:10	Si photo sensor on PI	T. Higashizako	M2
14:10~14:25	Self-Biased Oxide TFT Amplifier	Y. L. Han	M1
14:25~14:40	Coffee Break		
14:40~14:55	Si TFT on Glass	Y. Ishiki	M1

15:05~15:20	Effect of SOG Annealing Ambient on IGZO TFTs	Y. J. Baek	M1
15:20~15:35	Stretchable Pixel Circuit	S. M. Park	M1
15:35~15:45	Gate Insulator I	M. H. Kim	U
15:45~15:55	Gate Insulator II	S. W. Lee	U
15:55~16:05	Evaluation of SOG Film by Dilution Ratio	S. M. Lee	U
16:05~16:20	LCD Drive Circuit Using Oxide TFT for Wearable Applications	M. S. Kang	M1
16:20~16:30	Activation of Si film I	K. Ishii	U
16:30~16:40	Summary remark by Prof. Okada	T. Okada	Prof.
16:40~16:50	Summary remark by Prof. Bae	B. S. Bae	Prof.
16:50~17:00	Take a picture		

以上